



关于 T/CASAS 027—2023《射频 GaN HEMT 外延片二维电子气迁移率非接触霍尔测量方法》等 5 项团体标准发布的通知

各联盟成员单位：

按照 CASAS 相关管理办法，团体标准 T/CASAS 027—2023《射频 GaN HEMT 外延片二维电子气迁移率非接触霍尔测量方法》、T/CASAS 028—2023《Sub-6GHz GaN 射频器件可靠性筛选和验收方法》、T/CASAS 029—2023《Sub-6GHz GaN 射频器件微波特性测试方法》、T/CASAS 030—2023《GaN 毫米波前端芯片测试方法》、T/CASAS 031—2023《面向 5G 基站应用的 Sub-6GHz 氮化镓功放模块测试方法》已遵照流程完成制定工作，现予以发布。

T/CASAS 027—2023《射频 GaN HEMT 外延片二维电子气迁移率非接触霍尔测量方法》

本文件主要起草单位：中国科学院半导体研究所、厦门市三安集成电路有限公司、北京大学、中兴通讯股份有限公司、中国电子科技集团公司第十三研究所、LUVA SYTEM INC.、苏州能讯高能半导体有限公司、北京第三代半导体产业技术创新战略联盟。

本文件主要起草人：魏学成、刘波亭、杨学林、刘建利、宋学峰、Roger Luo、裴轶、徐瑞鹏。

T/CASAS 028—2023《Sub-6GHz GaN 射频器件可靠性筛选和验收方法》

本文件主要起草单位：中国电子科技集团公司第十三研究所、河北博威集成电路有限公司、北京国联万众半导体科技有限公司、中兴通讯股份

有限公司、西安电子科技大学、河北北芯半导体科技有限公司、苏州能讯高能半导体有限公司、北京第三代半导体产业技术创新战略联盟。

本文件主要起草人：默江辉、郭跃伟、刘相伍、刘建利、郑雪峰、迟雷、裴轶、徐瑞鹏。

T/CASAS 029—2023 《Sub-6GHz GaN 射频器件微波特性测试方法

本文件起草单位：中国电子科技集团公司第十三研究所、河北博威集成电路有限公司、北京国联万众半导体科技有限公司、中兴通讯股份有限公司、西安电子科技大学、河北北芯半导体科技有限公司、苏州能讯高能半导体有限公司、北京第三代半导体产业技术创新战略联盟。

本文件主要起草人：默江辉、郭跃伟、刘相伍、刘建利、郑雪峰、迟雷、裴轶、徐瑞鹏。

T/CASAS 030—2023 《GaN 毫米波前端芯片测试方法》

本文件起草单位：中国电子科技集团第五十五研究所、中兴通讯股份有限公司、北京大学、苏州能讯高能半导体有限公司、中国科学院半导体研究所、中国电子科技集团公司第十三研究所、北京第三代半导体产业技术创新战略联盟。

本文件主要起草人：周强、龚健伟、余旭明、刘建利、王茂俊、徐瑞鹏。

T/CASAS 031—2023 《面向 5G 基站应用的 Sub-6GHz 氮化镓功放模块测试方法》

本文件主要起草单位：中兴通讯股份有限公司、中国电子科技集团公司第十三研究所、中国电子科技集团公司第五十五研究所、苏州能讯高能半导体有限公司、厦门市三安集成电路有限公司、中国科学院半导体研究

所、西安电子科技大学、清华大学、北京大学、工业和信息化部电子第五研究所、北京第三代半导体产业技术创新战略联盟。

本文件主要起草人：封葳、王宇、段向阳、别业楠、刘建利、樊宁、王晖、董晶、默江辉、周强、裴轶、刘波亭、魏学成、郑雪峰、陈文华、王茂俊、蔡宗棋、徐瑞鹏。

特此通知。

第三代半导体产业技术创新战略联盟 2023年6月30日

